



【800～900万円】 SiCエピタキシャル成長プロセス開発エンジニア [53044]

ルネサス エレクトロニクス株式会社での募集です。 プロセスエンジニア（半導体） ...

Job Information

Recruiter

JAC Recruitment Co., Ltd.

Hiring Company

ルネサス エレクトロニクス株式会社

Job ID

1488137

Industry

Electronics, Semiconductor

Job Type

Permanent Full-time

Location

Ehime Prefecture

Salary

8 million yen ~ 9 million yen

Work Hours

08:30 ~ 17:15

Holidays

【有給休暇】 初年度 23日 1か月目から 【休日】 完全週休二日制 土 日 祝日 夏季休暇 年末年始 【有給休暇】 入社月に付与 (...)

Refreshed

August 15th, 2024 21:00

General Requirements

Career Level

Mid Career

Minimum English Level

Business Level

Minimum Japanese Level

Native

Minimum Education Level

Bachelor's Degree

Visa Status

Permission to work in Japan required

Job Description

【求人No NJB2133826】

【担当技術】

SiCエピタキシャル成長プロセス開発エンジニア

【担当業務】

SiCエピタキシャル成長装置立ち上げ、プロセス条件出し、量産化

【担当職場】

自社前工程国内拠点

Required Skills

【MUST】

SiCエピタキシャル成長プロセス開発の従事経験が2年以上あること。

【WANT】

4年制大学または大学院にて工学、化学、物理学等を修了していること。

Company Description

各種半導体に関する研究、開発、設計、製造、販売およびサービス